









	<h2 style="color: red;">MTD10N10ELT4</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: MTD10N10ELT4</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 10A DPAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  MTD10N10ELT4.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 5534 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	MTD10N10ELT4
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 10A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5534 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Verlustleistung (max)	1.75W (Ta), 40W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	220 mOhm @ 5A, 5V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1040pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































MTD10N10ELT4 ist neu im Original, Suche MTD10N10ELT4 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie MTD10N10ELT4 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage MTD10N10ELT4: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>MTD10N10ET4 ON MTD10N10ET4 ON</p>	 <p>MTD10N10EL O MTD10N10EL O</p>	 <p>MTD10N10ELT4G ON MTD10N10ELT4G ON</p>	 <p>MTD1114M3B Marktech Optoelectronics PHOTO DIODE 925NM</p>
 <p>MTD110-18V LTO IGBT Modules</p>	 <p>MTD10N10 Original TO-225</p>	 <p>MTD10N05ET4 ON MTD10N05ET4 ON</p>	 <p>MTD1120 SHINDEN SHINDEN ZIP-27</p>

heiße Teile

Mehr

 LNK605DG-TL	 MTD002-LF-00	 MTD003-LF-51	 MTD005-LF-10	 MTD10N05
 MTD10N05E	 MTD10N05ET4	 MTD10N06G	 MTD10N10EL	 MTD10N10ELT4G
 MTD10N10ET4	 MTD110-18V	 MTD12N06ET4G	 MTD12N06EZL	 MTD160-18V
 MTD3055EL	 MTD3055EL1	 MTD3055ELT4	 MTD3055ELT4G	 MTD3055ET4
 MTD3055V	 MTD3055V	 MTD3055VL	 MTD3055VL	 MTD3055VLG
 MTD3055VLT4	 MTD3055VLT4G	 MTD3055VT4	 MTD3055VT4G	 MTD30N10Q8
 MTD400DG220	 MTD40A08N	 MTD4100-B	 MTD45A08F	 MTD45A08F-K
 MTD45A08FK	 MTD45A12FK	 MTD45N08F	 MTD55A08FK	 MTD55A12FK
 MTD6N10RL	 MTD6N20ET4G	 MTD6P10E	 MTD6P10ET4	 MTD90-04A
 MTD91A16/25N	 MTD95A08FK	 MTD95A12FK	 SA53776258	 T1986N12TOF

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited